6 実験 B5 トランジスタの静特性

6.1 実験目的

トランジスタのエミッタ接地における静特性を測定し、トランジスタの基本動作を理解する.

6.2 実験回路

図 6.1 を基に回路を組む. 静特性実験専用の基盤を用いて実験を行うので、説明を良く聞くこと. 表 6.1 は使用する器具を示している. それぞれを基板に接続し、ディジタルマルチメータを使用して V_{BE} , V_{CE} を測定する.

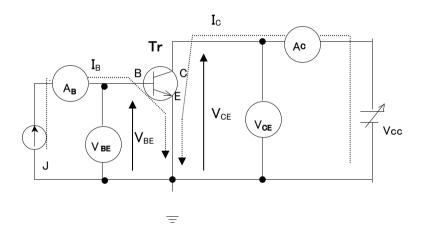


図 6.1 エミッタ接地の静特性測定回路

	₹ 0.1 C/II冊六
図の記号	機器の名称
Tr	供試トランジスタ (2SC1815)
J	標準電圧電流発生装置
V_{CC}	直流低電圧電源
A_{B}	直流電流計 3/10/30/100 μ A
Ac	直流電流計 1/3/10/30 mA
V _{BE} , V _{CE}	ディジタルマルチメータ

表 6.1 使用器具

6.3 実験内容

一人で 1 個の Tr(トランジスタ) について測定すること. この Tr は実験 B6(トランジスタ増幅回路の製作)で使用する.

6.3.1 Vce-Ic 特性測定実験

- 1. 図 6.1 のように結線し、 J を 20 μ A にする.
- 2. 電圧源 Vcc により, コレクタ電圧 VcE を 0V から 12V まで変化させコレクタ電流 Ic を測定する.

変化が急峻なところは測定点を多めにとること. (立ち上がり、肩付近は 0.2 $\sim 0.3 V$ 刻み)

変化が少ないところは測定点を少なめにして良い.

- 3. ベース電流 IBを 40,60,80 μAとかえて 2.を行う.
- 4. 結果を表 6.2 のようにまとめる.

表 6.2 VCE-Ic 特性の測定結果

IB (μA)	20	40	60	80
Vce (V)	Ic (mA)	Ic (mA)	Ic (mA)	Ic (mA)

6.3.2 VBE-IB 特性, Ic-IB 特性測定実験

- 1. 図 6.1 で、Vcc により VcE=1 V とする.
- 2. $J に より, IB を 0 から 50 \mu A まで 10 \mu A 刻みで変化させ VBE と Ic を測定する. また, IB の 0 <math>\mu$ A 付近は 0.2~0.3 μ A 刻みで数点測定する.
- 3. VCE を 4, 7V とかえて 2. を行う.
- 4. 結果を表 6.3 のようにまとめる.

表 6.3 VBE-IB 特性 と Ic-IB 特性の測定結果

Vce (V)	1		4		7	
IB (A∕V)	VBE (V)	Ic (mA)	VBE (V)	Ic (mA)	VBE (V)	Ic (mA)

6.4 静特性のグラフ作成

- 1. 以上の結果から、エミッタ接地回路の静特性(V_{BE} - I_B 特性、 I_B - I_C 特性、 V_{BE} - I_C 特性)のグラフを描け.図 6.2 は静特性のグラフである.図 6.2 を参考に作成すること.
- 2. VCE=4V, IB=40 μ A のときの動作点(各グラフの交点)をプロットせよ.
- 3. 上記 2. の動作点における次の各パラメータ (h_{EE}, R_{I}, Ro) をグラフから求めよ.
 - a. エミッタ接地直流電流増幅率 $h_{FE} = \frac{I_C}{I_R}$ (1)
 - b. 直流入力抵抗 $R_I = \frac{V_{BE}}{I_B} \qquad (2)$
 - c. 直流出力抵抗 $R_O = \frac{v_{CE}}{I_C} \qquad (3)$

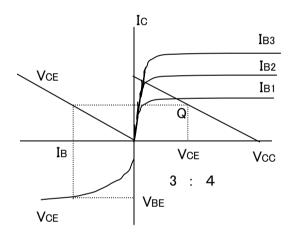


図 6.2 エミッタ接地のトランジスタ静特性

6.5 注意事項

- 1. 本実験で使用したトランジスタおよびその測定結果(表,グラフ)は,実験 B6 で用いるので,トランジスタは必ず出席番号が分かるようにして実験室に保管(指示有)すること.
- 2. 測定結果, グラフは必ず手元に各自保管し, 実験 B6 時に持参すること. 報告書にはコピー等を綴じること.